



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HB123D**

对应国外型号  
HLB123D

### 主要用途

功率放大

### 极限值 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-45~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极功率耗散 ( $T_C=25^\circ\text{C}$ ) .....	10W
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	500V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	400V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	8V
$I_C$ ——集电极电流.....	1A

### 电参数 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

### 外形图及引脚排列

TO-126ML



- 1 发射极, E
- 2 集电极, C
- 3 基极, B

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	500			V	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	8			V	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			10	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=500\text{V}, I_E=0$
$HFE1$	直流电流增益	10		65		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=300\text{mA}$
$HFE2$		10				$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			0.3	V	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$